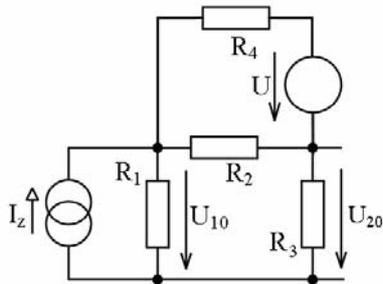


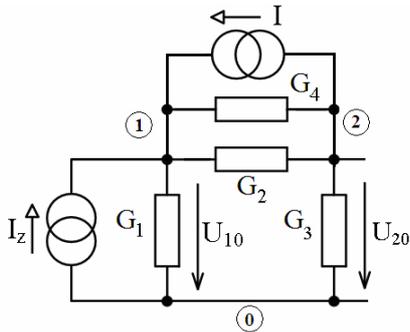
1 Elektrotechnika 1

Metodou uzlových napětí (MUN) vypočtete napětí U_{10} a U_{20} v uvedeném obvodu.



$$\begin{aligned} R_1 &= 2 \, \Omega, & R_2 &= 1 \, \Omega \\ R_3 &= 0,5 \, \Omega, & R_4 &= 1 \, \Omega \\ U &= 2 \, \text{V}, & I_z &= 2 \, \text{A} \end{aligned}$$

Řešení



$$I = \frac{U}{R_4} = 2 \, \text{A}$$

2 body

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 + G_4 & -G_2 - G_4 \\ -G_2 - G_4 & G_2 + G_3 + G_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I + I_z \\ -I \end{pmatrix}$$

2 body

$$\begin{pmatrix} 2,5 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

1 bod

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2,5 & -2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 6$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 12$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2,5 & 4 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = 3$$

3 body

$$U_{10} = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{12}{6} = 2 \, \text{V}$$

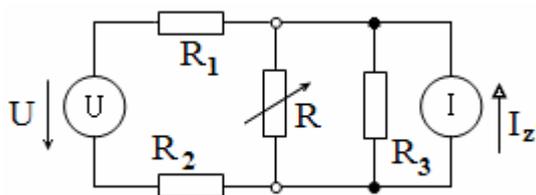
$$U_{20} = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{3}{6} = 0,5 \, \text{V}$$

2 body

(Pozn.: V případě jiné volby nezávislých uzlů, které **musí být v řešení vyznačené**, je třeba správné mezivýsledky s hodnotami odlišnými od vzorového řešení také adekvátně bodovat).

2 Elektrotechnika 1

Pomocí **Théveninovy věty** určete napětí na rezistoru R pro hodnoty: a) $R = 5 \Omega$, b) $R = 10 \Omega$.



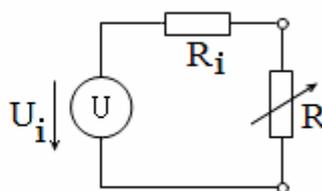
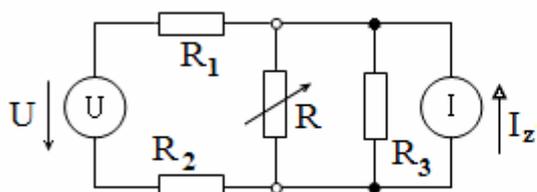
$$R_1 = R_2 = 5 \Omega$$

$$R_3 = 10 \Omega$$

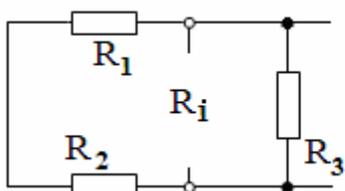
$$U = 10 \text{ V}$$

$$I_z = 1 \text{ A}$$

Řešení

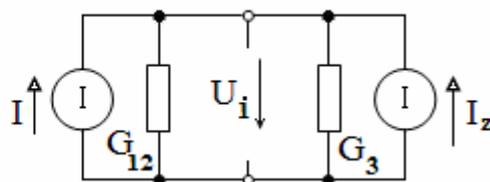


2 body



$$R_i = \frac{R_3 \cdot (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3} = 5 \Omega$$

1 bod



$$I = \frac{U}{R_1 + R_2} = 1 \text{ A}, \quad G_{i2} = \frac{1}{R_1 + R_2} = 0,1 \text{ S}$$

$$(G_{i2} + G_3)U_i = I + I_z$$

$$U_i = \frac{I + I_z}{G_{i2} + G_3} = \frac{2}{0,2} = 10 \text{ V}$$

3 body

$U_R = U_i \frac{R}{R + R_i}$	a) $U_R = 10 \frac{5}{5+5} = 5 \text{ V}$	b) $U_R = 10 \frac{10}{10+5} = 6,6 \text{ V}$
-------------------------------	---	---

2 body

1 bod

1 bod

3 Elektrotechnika 2

- a) Vyjádřete impedanci \mathbf{Z} sériového RLC obvodu a odvoďte jeho rezonanční kmitočet.
 b) Je-li fázor vstupního napětí RLC sériového obvodu \mathbf{U} , odvoďte velikosti fázoru proudu \mathbf{I} , a fázorů napětí na jednotlivých prvcích obvodu (\mathbf{U}_R , \mathbf{U}_L , a \mathbf{U}_C) při rezonanci.
 c) Nakreslete fázorový diagram fázorů sériového obvodu RLC při rezonanci.
 d) Sériový obvod má prvky: $R = 100 \Omega$, $L = 0,1 \text{ H}$, $C = 1 \text{ nF}$. Vypočtete jeho úhlový rezonanční kmitočet ω_0 a činitel jakosti Q .

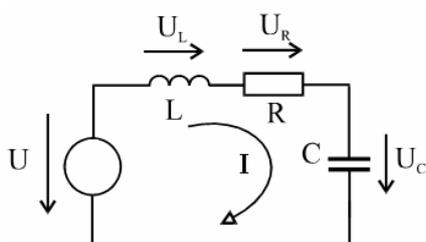
Řešení

a)
$$\mathbf{Z} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$\Rightarrow \min \mathbf{Z} = R \quad \text{pro } \omega L = \frac{1}{\omega C}, \quad \text{tj } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}) \dots \dots \dots \text{rezonance}$$

2 body

b)



při rezonanci: $\mathbf{I}_r = \frac{\mathbf{U}}{R} \Rightarrow$

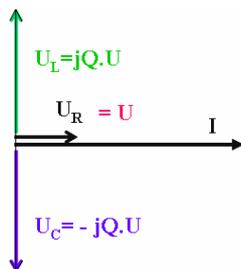
$$\mathbf{U}_{Lr} = \mathbf{I}_r \cdot j\omega_0 L = \frac{\mathbf{U}}{R} \cdot j\omega_0 L = jQ\mathbf{U},$$

$$\mathbf{U}_{Cr} = \mathbf{I}_r \cdot \frac{1}{j\omega_0 C} = \frac{\mathbf{U}}{j\omega_0 CR} = -jQ\mathbf{U},$$

$$\mathbf{U}_{Rr} = \mathbf{I}_r \cdot R = \mathbf{U}, \quad \text{kde } Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

4 body

c)



2 body

d)

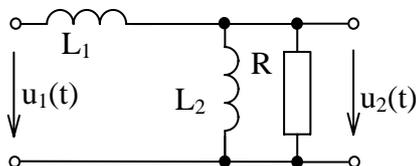
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} = \frac{1}{\sqrt{0,1 \cdot 1 \cdot 10^{-9}}} = 1 \cdot 10^5 \text{ rad/s},$$

$$Q = \frac{\omega_0 \cdot L}{R} = \frac{10^5 \cdot 0,1}{100} = 100$$

2 body

4 Elektrotechnika 2

Pro uvedený obvod odvodte obecný výraz pro obraz napětového přenosu $\mathbf{K}_U(p)$ a vyčíslete jej pro uvedené parametry obvodu. Vypočtete odezvu obvodu na jednotkový impuls $g(t)$ v číselném tvaru a uveďte její hodnoty pro $t = 0$, $t = \infty$ (zpětnou inverzi obrazu $\mathbf{G}(p)$ proveďte pomocí Heavisideova vztahu).



$$\begin{aligned}L_1 &= 1 \text{ H} \\R &= 20 \text{ } \Omega \\L_2 &= 4 \text{ H}\end{aligned}$$

Řešení

$$\mathbf{K}_U(p) = \frac{\frac{pL_2 \cdot R}{pL_2 + R}}{pL_1 + \frac{pL_2 \cdot R}{pL_2 + R}} = \frac{pL_2 R}{p^2 L_1 L_2 + pR(L_2 + L_1)} = \frac{80p}{4p^2 + 100p} = \frac{80}{4p + 100} \quad \mathbf{2 \text{ body}}$$

$$\mathbf{G}(p) = \mathbf{K}_U(p) \quad \mathbf{1 \text{ bod}}$$

Inverze obrazu:

$$\mathbf{G}(p) = \frac{80}{4p + 100} = \frac{Q(p)}{P(p)}, \quad P'(p) = \frac{d}{dp} P(p) = 4 \quad \mathbf{1 \text{ bod}}$$

kořen jmenovatele:

$$4p + 100 = 0 \Rightarrow p = -25 \quad \mathbf{1 \text{ bod}}$$

$$Q(p) = 80, \quad P'(p) = 4 \quad \mathbf{2 \text{ body}}$$

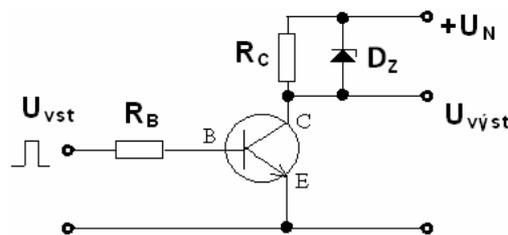
odezva na jednotkový impuls je

$$g(t) = L^{-1} \{ \mathbf{G}(p) \} = \frac{Q(p)}{P'(p)} e^{pt} = 20 \cdot e^{-25t} \quad \mathbf{2 \text{ body}}$$

$$g(0) = 20, \quad g(\infty) = 0 \quad \mathbf{1 \text{ bod}}$$

5 Elektronické součástky

- a) Tranzistorový spínač má napájecí napětí $U_N = 10\text{ V}$, $R_B = 1\text{ k}\Omega$, $R_C = 100\ \Omega$. Závěrné napětí stabilizační diody D_Z je 5 V . Na vstup je připojen obdélníkový signál ($f = 500\text{ Hz}$) s amplitudou $u_{VST1} = \pm 0,4\text{ V}$ nebo s amplitudou $u_{VST2} = \pm 4\text{ V}$. V uvažované pracovní oblasti je proudový zesilovací činitel tranzistoru $h_{21E} = 100$. Na základě výpočtu rozhodněte, v jakém režimu tranzistor při vstupním signálu u_{VST1} a při vstupním signálu u_{VST2} pracuje.
- b) Jak určíme diferenciální odpor emitoru r_E bipolárního tranzistoru? Jaká je souvislost r_E s admitančními parametry tranzistorového zesilovače v zapojení SE?
- c) Uveďte alespoň dva rozdíly mezi spínačem s bipolárním tranzistorem a tranzistorem MOSFET. Zdůvodněte.



Řešení

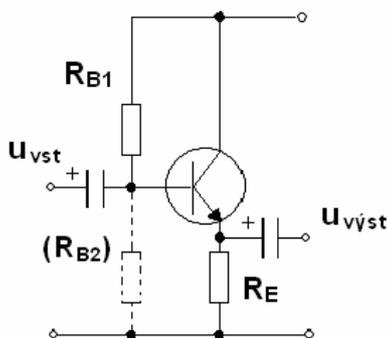
- a) $I_B = (U_{vst} - U_{BE}) / R_B$, $I_C = h_{21E} \cdot I_B$, $U_{RC} = R_C \cdot I_C$, $U_{CE} = U_N - U_{RC}$ 1 bod
- $u_{VST1} = +0,4\text{ V}$: $I_B = (0,4 - 0,6)\text{ V} / 1\text{ k}\Omega = -0,4\text{ mA}$!!! Vstupní napětí je příliš malé k otevření tranzistoru = závěrný režim. 1 bod
- $u_{VST1} = -0,4\text{ V}$: U_{BE} je záporné, $I_B \sim 0$, $I_C \sim 0$, $U_{RC} \sim 0$, $U_{CE} \sim U_N$ = závěrný režim. 1 bod
- $u_{VST1} = +4\text{ V}$: $I_B = (4 - 0,6)\text{ V} / 1\text{ k}\Omega = 3,4\text{ mA}$, $I_C = 100 \cdot 3,4 = 340\text{ mA}$,
 $U_{RC} = 100\ \Omega \cdot 340\text{ mA} = 34\text{ V}$ (!)
 U_{RC} nemůže být větší než závěrné napětí paralelně zapojené stabilizační diody D_Z !! Většinu proudu I_C proto převezme stabilizační dioda.
 Proto $U_{RC} = U_{DZ} = 5\text{ V}$ a $U_{CE} = U_{CC} - U_{DZ} = 5\text{ V}$ = aktivní režim. 2 body
- $u_{VST1} = -4\text{ V}$: U_{BE} je záporné, $I_B \sim 0$, $I_C \sim 0$, $U_{RC} \sim 0$, $U_{CE} \sim U_N$ = závěrný režim. 1 bod
- b) $r_E = U_T / I_E \sim U_T / I_C$ 1 bod
 $y_{21} = 1 / r_E$ 1 bod
- c) 1. Řídicí signál: **BT** - trvalý proud báze, $U_{BE} < 1\text{ V}$, **MOSFET** nepotřebuje v klidu žádný řídicí proud, při sepnutí i vypnutí je však nutné nabít a vybit parazitní kapacity v obvodu, $U_{GS} > 10\text{ V}$.
 2. Rychlost rozepnutí: **BT** - je zde vždy určité zpoždění dané akumulací nosičů, **MOSFET** - rychlost rozepnutí je určena schopností řídicích obvodů nabít a vybit parazitní kapacity.
 3. MOSFET pro $U_{DSmax} < 100\text{ V}$ má mnohem větší I_{Dmax} než srovnatelný BT.
 4. MOSFET pro $U_{DSmax} > 200\text{ V}$ má mnohem menší I_{Dmax} než srovnatelný BT. 2 body

6 Elektronické součástky

- a) Nakreslete příklad zapojení zesilovače tř. A v zapojení SC. Uvedte typický příklad použití tohoto zesilovače a zdůvodněte. Uvedte vztah pro výpočet jeho napěťového a proudového zesílení.
- b) Jaký parametr potřebujeme znát pro výpočet výstupního odporu bipolárního tranzistoru v zapojení SE a SB ($\sim r_C$). Uvedte vztah pro výpočet.
- c) Uvedte alespoň dva rozdíly mezi spínačem s tyristorem a s tranzistorem IGBT.

Řešení

a)



3 body

Zapojení SC je výhodné jako vstupní i výstupní obvod u zesilovačů, protože má velký vstupní a malý výstupní odpor. Proudové zesílení je rovno β , napěťové zesílení je ale menší než jedna. Napěťové zesílení celého zesilovače musí být zajištěno jiným typem zesilovače – obvykle BT v zapojení SE.

$$A_U = R_E / (R_E + r_E), \quad \text{kde } r_E = U_T / I_E \quad \mathbf{1 \text{ bod}}$$

$$A_I = \beta \quad \mathbf{1 \text{ bod}}$$

- b) Je třeba znát Earlyho napětí U_E – určíme jej pomocí průsečíku prodloužené části výstupní charakteristiky s osou napětí.

$$\text{S použitím } U_E \text{ vypočteme } r_C \text{ takto: } r_C = R_{CE} = (U_E + U_{CE}) / I_C .$$

2 body

- c) 1. Řídicí signál: **Tyristor** vyžaduje proudový impuls I_G , $U_{GK} \sim 2V$, tranzistor **IGBT** je řízen napětím, ale při sepnutí i vypnutí je nutné nabít a vybit parazitní kapacity v obvodu, $U_{GS} > 10V$.
2. Rozepnutí: **Tyristor** zůstává sepnutý, dokud proud tyristorem neklesne pod úroveň vratného proudu. **IGBT** vypíná bezprostředně po změně napětí na hradle.
3. Mezní kmitočet: **Tyristor** je bipolární součástka, je zde vždy akumulace nosičů a mezní kmitočet je proto omezen na několik kHz. U **IGBT** je možné vhodným rozmístěním rekombinačních center dosáhnout mezního kmitočtu přes 50 kHz.

2 body

7 Signály, soustavy, systémy

Určete, zda je signál $s(t)$ periodický: $s(t) = 2\pi \cos(2\pi t) + 4 \cos t$

Řešení

Perioda první složky signálu $2\pi \cos(2\pi t)$: $T_1 = 1$ **3 body**

Perioda druhé složky signálu $4 \cos t$: $T_2 = 2\pi$ **3 body**

Kritérium periodicity

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{2\pi} \Rightarrow \text{iracionální číslo} \Rightarrow \text{signál } s(t) \text{ není periodický} \quad \mathbf{4 \text{ body}}$$

(Za správnou odpověď lze považovat také výrok: signál $s(t)$ je kvaziperiodický.)

8 Signály, soustavy, systémy

Signály s diskretním časem. Diskrétní čas je označen symbolem k .

- a) Pro $k = 2$ určete hodnotu signálu $f_a(k) = 4 \cos(0,5\pi k + 0,5\pi)$.
- b) Pro $k = 2$ určete hodnotu signálu $f_b(k) = \delta(k + 4)$.
- c) Pro $k = 2$ určete hodnotu signálu $f_c(k) = -2\sigma(k - 1)$.
- d) Pro $k = 2$ určete hodnotu signálu $f_d(k) = 4 \cos(0,5\pi k + 0,5\pi) + \delta(k + 4) - 2\sigma(k - 1)$.

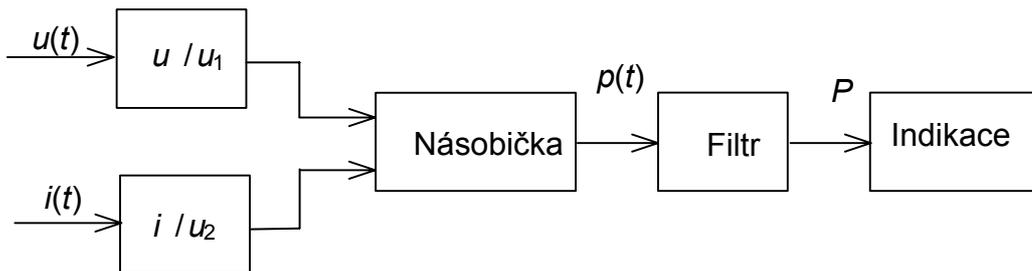
Poznámka: $\sigma(k)$ je diskretní jednotkový skok, který také bývá označován $\sigma(n)$, $1(n)$, $u(n)$.
 $\delta(k)$ je diskretní jednotkový impuls

Řešení

- a) $f_a(2) = 4 \cos(0,5\pi \cdot 2 + 0,5\pi) = 4 \cos(1,5\pi) = 0$. **3 body**
(Hodnotí se pouze správnost číselného výsledku)
- b) $f_b(2) = \delta(2 + 4) = 0$. **3 body**
- c) $f_c(2) = -2\sigma(2 - 1) = -2\sigma(1) = -2$. **2 body**
- d) $f_d(2) = -2$. **2 body**

9 Měření v elektrotechnice

Nakreslete blokové schéma analogového elektronického průchozího wattmetru. Uveďte funkce jednotlivých bloků a jakými typy obvodů je lze realizovat.

Řešení**5 bodů**

Základním obvodem elektronických wattmetrů je násobička, u přesných přístrojů obvykle s amplitudově šířkovou modulací, lze však použít i násobičku s Hallovou sondou.

2 body

Převod u/u_1 je nejčastěji proveden kmitočtově kompenzovaným odporovým děličem nebo měřicím transformátorem napětí. Pokud jsou místo rezistorů použity termočlánky, získáme zapojení vhodné pro měření výkonu vř proudů.

1 bod

Převod i/u_2 je obvykle realizován bočníkem nebo měřicím transformátorem, případně lze použít převodník s operačním zesilovačem.

1 bod

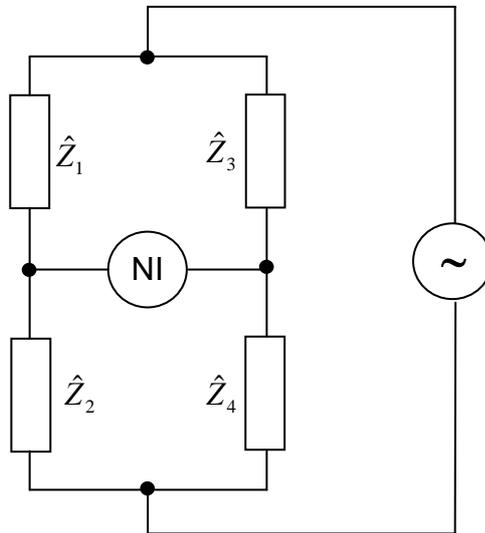
Střední hodnota je získána filtrem typu dolní propust.

1 bod

10 Měření v elektrotechnice

Nakreslete základní zapojení střídavých můstků Wheatstoneova typu a uveďte jejich podmínky rovnováhy.

Řešení



3 body

Podmínka rovnováhy $\hat{Z}_1 \cdot \hat{Z}_4 = \hat{Z}_2 \cdot \hat{Z}_3$, 2 body

kde $\hat{Z} = R + jX$. 1 bod

Oddělením reálných a imaginárních částí impedancí získáme dvě podmínky rovnováhy

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} [\hat{Z}_1 \cdot \hat{Z}_4] &= \operatorname{Re} [\hat{Z}_2 \cdot \hat{Z}_3], \\ \operatorname{Im} [\hat{Z}_1 \cdot \hat{Z}_4] &= \operatorname{Im} [\hat{Z}_2 \cdot \hat{Z}_3]. \end{aligned} \quad 1 \text{ bod}$$

Pokud zapíšeme impedance v exponenciálním tvaru, získáme komplexní podmínku rovnováhy

$$Z_1 \cdot Z_4 \cdot e^{j(\varphi_1 + \varphi_4)} = Z_2 \cdot Z_3 \cdot e^{j(\varphi_2 + \varphi_3)}, \quad 1 \text{ bod}$$

kterou můžeme rozepsat na dvě podmínky

$$\begin{aligned} Z_1 \cdot Z_4 &= Z_2 \cdot Z_3, \\ \varphi_1 + \varphi_4 &= \varphi_2 + \varphi_3. \end{aligned} \quad 2 \text{ body}$$

Pokud je v některé z podmínek rovnováhy zastoupen kmitočet, je můstek kmitočtově závislý a lze jej použít nejen k měření impedancí, ale také k měření kmitočtů.